



Technique

Réacteur d'implantation en immersion plasma

TAPIIR

(Thermally Assisted Plasma Ion Implantation Reactor)

Caractéristiques-performances :

Plasma Radio Fréquence
Pression de base $\leq 10^{-7}$ mb
Polarisation de l'échantillon jusqu'à 30 kV
Température de l'échantillon 250°C to 900°C

Principales caractéristiques :

Plasma Radio Fréquence (13.56 MHz)
Impulsions haute tension 800V à 30 kV; max 50 A current; durée max 50 μ s; fréquence max 1kHz
Dimensions de l'échantillon ϕ 30 mm x L 100 mm maximum
Pompage turbo moléculaire, pression de base $\leq 10^{-7}$ mb
Chauffage de l'échantillon par four externe

Applications typiques :

Modification de la surface de métaux en vue d'améliorer leurs propriétés mécaniques :
Performances tribologiques
Durée de vie en fatigue

Contact: Michel Drouet (IR)

Luc Pichon (PR)